

## КТ325Б

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n усилительные с ненормированным коэффициентом шума.

Предназначены для применения в усилителях высокой частоты.

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами.

Тип приборов 2Т325А, 2Т325Б, 2Т325В, КТ325А, КТ325Б, КТ325В указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 1,2 г.

Тип корпуса: КТ-2-3.

Технические условия: СБ0.336.047 ТУ.

Основные технические характеристики транзистора КТ325Б:

- Структура транзистора: n-p-n;
- $P_{к\max}$  - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 225 мВт;
- $f_{гр}$  - Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее 800 МГц;
- $U_{кэ\max}$  - Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при заданном токе коллектора и заданном (конечном) сопротивлении в цепи база-эмиттер: 15 В (3кОм);
- $U_{эб\max}$  - Максимальное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 4 В;
- $I_{к\max}$  - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 60 мА;
- $I_{кб\text{о}}$  - Обратный ток коллектора - ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера: не более 0,5 мкА;
- $h_{21Э}$  - Статический коэффициент передачи тока для схемы с общим эмиттером в режиме большого сигнала: 70... 120;
- $C_{к}$  - Емкость коллекторного перехода: не более 2,50 пФ;
- $t_{к}$  - Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте: не более 125 пс

### Технические характеристики транзисторов КТ325А, КТ325Б, КТ325В:

Тип транзистора	Структура	Предельные значения параметров при $T_{п}=25^{\circ}\text{C}$						Значения параметров при $T_{п}=25^{\circ}\text{C}$						$T_{п\max}$ °C	$T_{\max}$ °C	
		$I_{к\max}$	$I_{к.и.\max}$	$U_{кэR\max}$	$U_{кб0\max}$	$U_{эб0\max}$	$P_{к\max}$	$h_{21Э}$	$U_{кэ\text{на с.}}$	$I_{кб\text{о}}$	$f_{гр.}$	$C_{кш}$	$C_{кэ}$			
		мА	мА	В	В	В	мВт		В	мкА	МГц	дБ	пФ			пФ
КТ325А	n-p-n	60	60	15	15	4	225	30...90	-	0,5	800	-	2,5	2,5	150	- 60...+125
КТ325Б	n-p-n	60	60	15	15	4	225	70...210	-	0,5	800	-	2,5	2,5	150	- 60...+125
КТ325В	n-p-n	60	60	15	15	4	225	160...400	-	0,5	1000	-	2,5	2,5	150	- 60...+125

### Условные обозначения электрических параметров транзисторов:

- **$I_{к\max}$**  - максимально допустимый постоянный ток коллектора транзистора.
- **$I_{к.и.\max}$**  - максимально допустимый импульсный ток коллектора транзистора.
- **$U_{кэR\max}$**  - максимальное напряжение между коллектором и эмиттером при заданном токе коллектора и сопротивлении в цепи база-эмиттер.
- **$U_{кэ0\max}$**  - максимальное напряжение между коллектором и эмиттером транзистора при заданном токе коллектора и токе базы, равным нулю.
- **$U_{кб0\max}$**  - максимальное напряжение коллектор-база при заданном токе коллектора и токе эмиттера, равным нулю.
- **$U_{эб0\max}$**  - максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база при токе коллектора, равном нулю.
- **$P_{к\max}$**  - максимально допустимая постоянная мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора.
- **$h_{21Э}$**  - статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора.
- **$h_{21э}$**  - коэффициент передачи тока биполярного транзистора в режиме малого сигнала в схеме с общим эмиттером.
- **$U_{кэ\text{нас.}}$**  - напряжение насыщения между коллектором и эмиттером транзистора.
- **$I_{кб0}$**  - обратный ток коллектора. Ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера.
- **$f_{гр}$**  - граничная частота коэффициента передачи тока.
- **$K_{ш}$**  - коэффициент шума транзистора.
- **$C_{к}$**  - емкость коллекторного перехода.
- **$C_{э}$**  - емкость коллекторного перехода.
- **$T_{п\max}$**  - максимально допустимая температура перехода.
- **$T_{\max}$**  - максимально допустимая температура окружающей среды.